



Si-npn-Leistungsschaltransistoren vorzugsweise für den Einsatz in Schaltnetzteilen

Bauform 5 TO3

**Grenzwerte**

	SU 191	SU 192
$U_{CEX}$	160	300 V
$U_{CEO}$	125	250 V
$I_C$	20	15 A
$I_{CM}$	25	20 A
$\vartheta_j$	200	200 °C

**Kennwerte bei  $\vartheta_j = 25\text{ °C}$**

	max	max
$U_{CEsat}$ ( $I_C = 15,0\text{ A}, I_B = 1,5\text{ A}$ )	1,2	V
$U_{CEsat}$ ( $I_C = 10,0\text{ A}, I_B = 1,0\text{ A}$ )		0,9 V
$U_{BEsat}$ ( $I_C = 15,0\text{ A}, I_B = 1,5\text{ A}$ )	2,0	V
$U_{BEsat}$ ( $I_C = 10,0\text{ A}, I_B = 1,0\text{ A}$ )		2,0 V
$t_f$ ( $I_C = 15,0\text{ A}, I_B = 1,5\text{ A}, -I_B = 1,5\text{ A}$ )	0,8	$\mu\text{s}$
$t_f$ ( $I_C = 10,0\text{ A}, I_B = 1,0\text{ A}, -I_B = 1,0\text{ A}$ )		0,8 $\mu\text{s}$
$R_{thjc}$	1,17	1,17 K/W